



JZ2602 用户数据手册

V1.0

8 位 OTP MCU 系列开发资料

**无锡晶哲科技资料权力声明:**

资料级别	保密级别	发放方式	签订保密协议
外发资料	公开	通用发放	不需要

所有资料所有权归无锡晶哲科技有限公司所有。未经无锡晶哲科技有限公司的书面许可,不得翻印或者复制全部或者部分资料的内容。

本资料是为了让用户根据无锡晶哲科技有限公司的 MCU 产品功能和性能选择合适产品的参考资料,不属于无锡晶哲科技产品知识产权和其他权力给应用方或者第三者授权许可。

本资料说有数据、图、表、程序、算法以及其它应用电路的例子,是在无锡晶哲科技有限公司在自定义的测试评价条件下的结果推荐,不是所有应用环境和场合和测试条件的

测试数据,仅供参考,不是最终的解决方案和测试数据。用户在使用本产品前请根据实际应用场合和条件进行完整的测试和评价,对于因使用本资料所记载的产品数据、图、表、程序、算法以及其它应用电路的例子而引起的使用者在系统方案或者产品的研发或者生产中出现的经济损失,无锡晶哲科技有限不承担责任。

无锡晶哲科技服务联系方式:

公司地址:江苏省无锡市新区菱湖大道 228 号天安智慧城 A1 栋 10 层

公司传真: 0510-88234811;

公司网址: www.wxjzkj.com

技术服务: 18852463313

深圳晶哲科技服务联系方式:

地址:深圳市南山区科慧路 1 号沛鸿产业园 A1 栋 501B 公司电话:0755-27363603

0755-29173200

公司传真: 0755-29746209 公司网址: www.wxjzkj.com

技术服务: 0755-36628559



1 电路综述

1.1 概述

JZ2602 是一款基于 CMOS 技术的高速度低功耗的 8 位 MCU，内置 2K*16bit OTP ROM，并提供保护位用以保护指令码。此芯片最大的优势是内部带有 256*8bit 的 EEPROM。

JZ2602 是一个基于 CMOS 技术的 8 微控制器，其核心是一个嵌入式的 8 位 CPU，片内包含 80*8bit 的 SRAM，2K*16bit OTP ROM，6 个输入/输出口、中断控制器、片内 RC 振荡器、内部晶体振荡器、定时器/计数器、看门狗电路、低压检测电路、数模转换电路、比较器/运放电路、脉宽调制电路。它是一个功能强大的微控制电路。

作为一个通用 MCU，主要应用于移动电源、高端智能充电器、电动车主控板等。

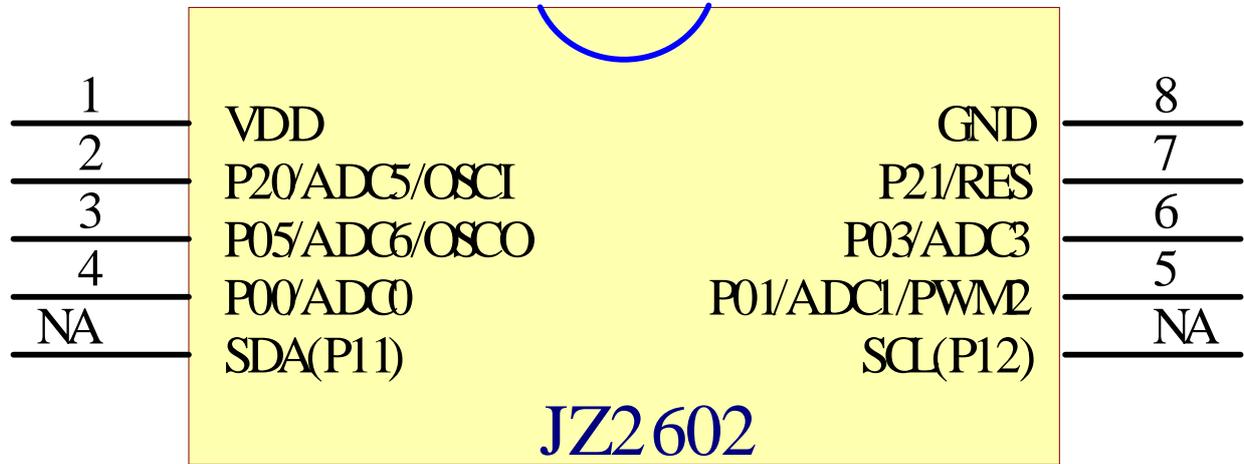
1.2 主要特性

- 2k×16-bit OTP ROM
- 80×8-bit SRAM
- 8 级堆栈空间
- 可编程 WDT 预分频器
- 可编程 WDT 时间（4.5ms、18ms），可控制 WDT 自由运行时间
- 带信号源选择、触发沿选择、溢出中断及预分频器的 8 位实时时钟/计数器（TCC）
- 工作电压范围：2.1V~5.5V（-0℃~70℃）2.3V~5.5V（-40℃~85℃）
- 工作频率范围（2 分频）：
 - 晶振模式：DC~16MHz，4.5V；DC~8MHz，3V；DC~4MHz，2.1V；
 - ERC 模式：DC~2MHz，2.1V；
 - IRC 模式：16MHz，4MHz，1MHz，8MHz；
- 系统高低频率的变化点是 400kHz
- 低功耗：
 - 小于 1.5 mA（4MHz/5V）
 - 典型 15uA（32kHz/3V）
 - 典型 2uA（睡眠模式，WDT 关闭，LVD 关闭）
- 低压复位：4.0V±0.3V、3.5V±0.3V、2.7V±0.2V@25℃
- 低压检测：4.5±0.2V、4.0±0.2V、3.3±0.2V、2.2±0.2V@25℃
- 中断源：
 - TCC 溢出中断（IDLE 模式唤醒）
 - 外部中断（SLEEP/IDLE 模式唤醒）
 - 比较器输出状态改变中断（SLEEP/IDLE 模式唤醒）
 - ADC 转换完成中断（SLEEP /IDLE 模式唤醒）
 - PWM1~2 周期中断（IDLE 模式唤醒）
 - PWM1~2 占空比中断（IDLE 模式唤醒）
 - P0 端口输入状态改变中断（SLEEP /IDLE 模式唤醒）
 - LVD 中断（SLEEP /IDLE 模式唤醒）
- 指令周期长度选择：2 个振荡时钟或 4 个振荡时钟
- 封装形式：JZ2602C0-SOP8



2 引脚说明

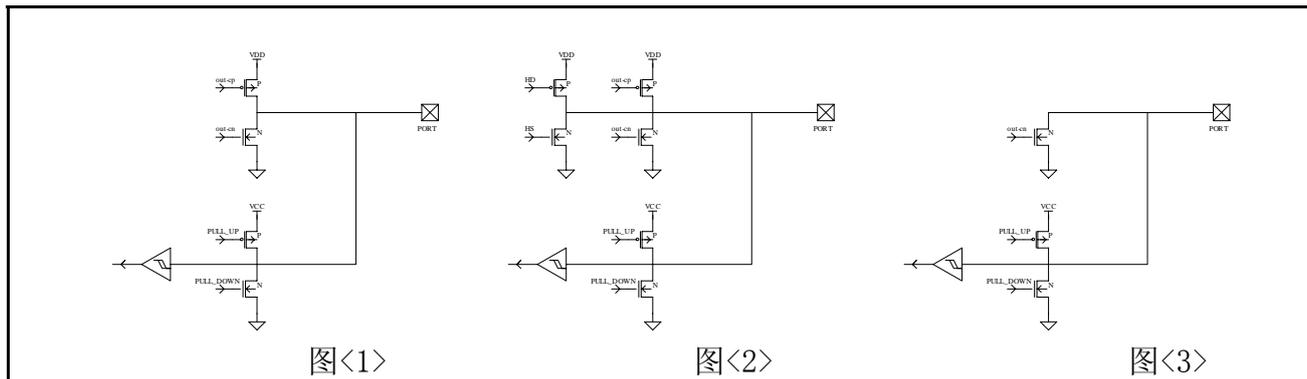
2.1 引脚排列



JZ2602-8PIN

2.2 引脚排列

序号	管脚名	I/O	功能描述	输入/输出电路
1	P00	I/O (上/下拉)	通用 I/O 口	图<1>
	ADC0	I (AN)	ADC INPUT 0	
2	P01	I/O (上/下拉)	通用 I/O 口	图<2>
	ADC1	I (AN)	ADC INPUT 1	
	PWM2	0	PWM2 输出口	
3	P03	I/O (上/下拉)	通用 I/O 口	图<2>
	ADC3	I (AN)	ADC INPUT 3	
4	P05	I/O (上/下拉)	通用 I/O 口	图<1>
	ADC6	I (AN)	ADC INPUT 6	
	OSCO	0 (XTAL)	振荡器输出口	
	ERCin	I (AN)	外部 RC 输入口	
5	P20	I/O	通用 I/O 口	图<1>
	ADC5	I (AN)	ADC INPUT 5	
	OSCI	I (XTAL)	振荡器输入口	
	RCOUT	0	RC 振荡器输出口	
6	P21	I/O	通用 I/O 口	图<3>
	/RESET	I (SMT)	复位脚	
7	VDD	--	电源	--
8	GND	--	地	--



2.3 EEPROM 控制信号说明

2.3.2 8PIN 控制信号说明

1PIN	VDD	EEPROM 电源线
8PIN	GND	EEPROM 地线
P12	SCL	EEPROM 时钟线
P11	SDA	EEPROM 数据线

EEPROM 电源线与 MCU 电源线相同且物理连接；
 EEPROM 地线与 MCU 地线相同且物理连接；
 EEPROM 数据线与 MCU 内部 P11 物理连接在一起；
 EEPROM 时钟线与 MCU 内部 P12 物理连接在一起；

2.4 EEPROM 使用说明

此芯片内部 EEPROM 的使用方法，完全符合标准的 I2C 串行总线控制方式，SCL 为单向时钟线，可以不用增加上拉电阻，SDA 为双向数据线需要增加上拉电阻。如没有上拉，主控器件无法从 EEPROM 中读取正确的数据。详细的芯片资料请参考我司的《JZ2601 用户数据手册 V2.4》，具体的 EEPROM 读写请参考 24C02 通信协议技术规范。



3 附录

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
引线框	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○
说明	○：表示该有毒有害物质的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求以下。×：表示该有毒有害物质的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。					

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
芯片	○	○	○	○	○	○
说明	○：表示该有毒有害物质的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求以下。×：表示该有毒有害物质的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。					